

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年3月15日 (2012.3.15)

【公開番号】特開2009-267366(P2009-267366A)

【公開日】平成21年11月12日 (2009.11.12)

【年通号数】公開・登録公報2009-045

【出願番号】特願2009-30450(P2009-30450)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/8247 (2006.01)

H 0 1 L 29/788 (2006.01)

H 0 1 L 29/792 (2006.01)

H 0 1 L 27/115 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 29/78 3 7 1

H 0 1 L 27/10 4 3 4

【手続補正書】

【提出日】平成24年1月30日 (2012.1.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

シリコン基板とゲート電極の間に、前記シリコン基板側から順に第 1 シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、第 2 シリコン酸化膜が積層した絶縁膜が介在した半導体記憶装置であって、

前記第 1 シリコン酸化膜と前記シリコン窒化膜の間の界面、前記シリコン窒化膜と前記第 2 シリコン酸化膜の間の界面、及び前記第 2 シリコン酸化膜と前記ゲート電極の間の界面の全て又は少なくとも 1 つの界面に水素吸蔵膜が介在することを特徴とする半導体記憶装置。